(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (43) Veröffentlichungstag: 07.06.2000 Patentblatt 2000/23
- (51) Int. Cl.7: G02B 1/02, G03F 7/20, G02B 13/14

(11)

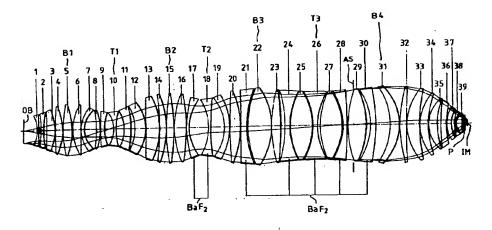
- (21) Anmeldenummer: 99121434.7
- (22) Anmeldetag: 28.10.1999
- (84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI
- (30) Priorität: 29.06.1999 DE 19929701 30.11.1998 DE 19855158 27.02.1999 DE 19908544

- (71) Anmelder:
 - **Carl Zeiss** 89518 Heidenheim (Brenz) (DE) Benannte Vertragsstaaten:
 - Carl-Zeiss-Stiftung trading as Carl Zeiss 89518 Heidenheim (Brenz) (DE) Benannte Vertragsstaaten:
- (72) Erfinder: Schuster, Karl-Heinz 89551 Königsbronn (DE)

Objektiv mit Kristall-Linsen und Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie (54)

Ein Objektiv mit Linsen aus zwei verschiedenen Kristallen, insbesondere CaF2 und BaF2, eignet sich besonders als refraktives Projektionsobjektiv der Mikrolithographie bei 157 nm. Derartige Projektionsobjektive für 193/248 nm mit Quarzglas und Achromatisierung mit CaF2 werden mit BaF2 Compaction-resistent. Mit anderen Fluoriden und teilweise katadioptrischen Objektiven werden Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlagen im Wellenlängenbereich 100 - 200 nm möglich.

F16.1



Beschreibung

- [0001] Die Erfindung betrifft ein Objektiv mit Kristall-Linsen. Derartige Objektive sind seit über hundert Jahren als Apochromat-Mikroskopobjektive von Carl Zeiss mit Flußspat (CaF₂)-Linsen bekannt.
- [0002] In jüngerer Zeit werden refraktive Projektionsobjektive für die Mikrolithographie im DUV bei 248 oder 193 nm Wellenlänge realisiert, die Linsen aus Quarzglas und CaF₂ enthalten.
 - [0003] Aus DD 222 426 B5 ist ein optisches System mit optischen Gläsern und BaF₂-Einkristall als optische Medien bekannt, das für Wellenlängen von 150 bis 10⁴ nm eingesetzt werden kann. Das Ausführungsbeispiel ist ein Planapochromat für 480 bis 800 nm mit mehreren verschiedenen Gläsern und BaF₂.
- [0004] Die Materialauswahl für UV-Mikrolithographieobjektive mit Schwerpunkt auf der Wellenlänge 248 nm ist in G. Roblin, J. Optics (Paris), 15 (1984) pp. 281-285 beschrieben.
 - Im Ergebnis werden nur Kombinationen von Quarzglas mit CaF2 oder LiF als brauchbar eingestuft.
 - [0005] In U. Behringer, F + M (München) $\underline{107}$ (1999), 57-60 sind für die 157 nm Mikrolithographie Fluoride wie CaF₂, M_gF₂ und LiF als geeignet beschrieben, mit Vorbehalten wegen der Doppelbrechung von MgF2 und wegen der Handhabung von LiF.
 - [0006] In K.F. Walsh et al., SPIE Vol. $\underline{774}$ (1987), 155-159 werden u.a. die Excimer-Laser für 248, 193 und 157 nm Wellenlänge vorgestellt und für 248 nm Quarzglas, CaF₂, BaF₂ und MgF₂ als einzig brauchbare Linsenmaterialien benannt. Für Wellenlängen unter 248 nm wird Quarzglas als einzig brauchbares Material erwartet.
- [0007] In US 5,031,977 wird ein katadioptrisches 1:1 Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie bei 248 nm beschrieben, das einen Konkavspiegel, eine Quarzglaslinse, eine LiF-Linse und zwei Umlenkprismen aus CaF₂ enthält. Argumente zur Materialauswahl sind ebensowenig angegeben wie Hinweise zu Abwandlungen der speziellen Konstruktion.
- [0008] Nahe bei 157 nm liegt jedoch die Absorptionskante von Quarzglas. CaF₂ transmittiert bei 157 nm noch brauchbar, hat aber eine zu hohe Dispersion für ein reines CaF₂-Objektiv der Mikrolithographie, auch für einen spektral eingeengten F₂-Excimer-Laser. Bisher sind daher Objektive für Wellenlängen unter 193 nm nur als katadioptrische- vgl. DE 196 39 586 A des gleichen Erfinders und Anmelders und US Prov. Appln. Ser. No. 60/094,579 vom 29. Juli 1998 des gleichen Anmelders oder katoptrische vgl. US 5,686,728 Systeme bekannt. Dabei gibt US 5,686,728 ein reines Spiegelobjektiv für die VUV-Mikrolithographie mit beispielsweise 126 nm, 146 nm oder 157 nm Excimer-Laser an.
- [0009] Aufgabe der Erfindung ist die Angabe eines alternativen Objektivkonzepts mit einer Materialzusammenstellung, die neue Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in der Mikrolithographie bei niedrigen Wellenlängen eröffnet.
 [0010] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Objektiv nach Anspruch 1, ein Projektionsobjektiv der Mikrolithographie nach Anspruch 4, oder 9, 11, 12 und eine Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 16, 17 oder 18. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche 2, 3, 5-8, 10, 14-16,19-21 und 23.
- [0011] Einen Teilaspekt gibt Anspruch 13 an.
- [0012] Ein Verfahren zur Herstellung mikrostruktuierter Bauteile gemäß Anspruch 22 sieht vor, daß ein mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenes Substrat mittels einer Maske und einer Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der Ansprüche 17 bis 21 und damit mit einem Objektiv nach einem der vorangehenden Ansprüche durch ultraviolettes Licht belichtet wird und gegebenenfalls nach Entwickeln der lichtempfindlichen Schicht entsprechend einem auf der Maske enthaltenen Muster strukturiert wird.
- [0013] Die Erfindung geht aus von der Erkenntnis, daß sich durch die Verwendung zweier verschiedener Kristalle in einem Objektiv neuartige Objektiveigenschaften bereitstellen lassen. Insbesondere gehört dazu die Möglichkeit der Achromatisierung bei niedrigen Wellenlängen, bei denen jedes bekannte Glas, auch Quarzglas, stark absorbiert. Die in der Mikrolithographie gegen BaF₂ vorhandenen Vorbehalte beziehen sich auf 248 nm und Quarzglas als Partner.
- [0014] Alkali- und Erdalkalihalogenide, speziell deren Fluoride, wie auch andere Fluoride sind als Optik-Werkstoff bekannt. Ihre zum Teil schwierigen Werkstoffeigenschaften haben bisher dazu geführt, daß ihre hervorragenden Transmissionseigenschaften im tiefen UV nur ansatzweise ausgenutzt wurden. Erfindungsgemäß wurde gezeigt, daß mit diesen und ähnlichen Materialien die optische Mikrolithographie bis zu ca. 100 nm Wellenlänge nach unten ausgedehnt werden kann.
 - [0015] Mit der Paarung zweier Fluoridkristalle, insbesondere von CaF₂ BaF2, SrF₂ LiF, NaF, oder KF, aber auch von Mischkristall-Fluoriden kann erstmals ein Materialpaar zur Achromatisierung von 157 nm-Optiken angegeben werden. Die Materialien sind bereits in der Optik-Fertigung bekannt, wie der angegebene Stand der Technik belegt. Bariumfluorid, Strontiumfluorid oder Natriumfluorid wird dabei entsprechend Anspruch 6 vorzugsweise für Negativlinsen verwendet, und zwar nur für einzelne, weil das genügen kann. Kalziumfluorid findet dann gemäß Anspruch 7 nicht nur für die Positivlinsen, sondern auch für die restlichen Negativlinsen Verwendung.
- [0016] Besonders vorteilhaft ist es gemäß Anspruch 8, daß numerische Aperturen über 0,5, auch bei 157 nm, erreicht werden. Das folgende Beispiel mit der numerischen Apertur von 0,8 belegt dies deutlich. Damit wird der Auflösungsvorsprung der EUV-Mikrolithographie durch ca. 1/10 der Wellenlänge teilweise kompensiert, da ca. die dreifache NA erreicht wird. Gegenüber 193 nm kann mit 109 nm aber die Auflösung fast halbiert werden., da das Niveau der NA

gehalten wird.. Für die Bearbeitungsgenauigkeit hat die zehnfache Wellenlänge gegenüber EUVL drastische Vorteile.

[0017] Das Stitching-Verfahren (zeilenweise Belichten des Chips) gemäß Anspruch 20, welches neuerdings in der Mikrolithographie bei sehr niedrigen Wellenlängen ins Gespräch kommt, erlaubt verkleinerte Bildfelder als Rechtecke mit mäßigem Aspektverhältnis und sorgt so für eine drastische Verkleinerung der Objektive. Letzteres entspannt die Herstellungsprobleme für die Linsenkristalle drastisch.

[0018] Eine ganz andere Ausführungsart der Erfindung gemäß den Ansprüchen 9 und 10 wurde überraschend gefunden:

Bei der DUV-Mikrolithographie mit 248 nm oder 193 nm tritt im Dauerbetrieb ein als "Compaction" bezeichneter Alterungsprozeß bei Quarzglas auf, durch den das Material verdichtet wird und in Folge Brechungsindex und Form der Linse verändert werden. Dies verschlechtert natürlich die Abbildungsleistung des Objektivs. Neben der Kompensation durch stellbare Glieder wurde erkannt, daß die am höchsten belasteten und betroffenen bildseitigen Linsen statt aus Quarzglas aus Kristall, nämlich vorzugsweise CaF₂, SrF₂ oder BaF₂ gefertigt werden können, die wesentlich stabiler gegen UV-Strahlung sind.

[0019] In der Patentanmeldung DE 19855157.6 des Anmelders vom gleichen Anmeldetag sind mehrere Ausführungsbeispiele mit derartigem Einsatz von Kalziumfluorid-Linsen enthalten, welche Teil der Offenbarung auch dieser Anmeldung sein sollen.

[0020] Dabei hat BaF₂ wie SrF₂ an dieser Stelle nach Anspruch 9 den - im Umfeld der Achromatisierung als Nachteil geltenden - Vorteil, sich in seinen optischen Eigenschaften wesentlich weniger von Quarzglas zu unterscheiden als CaF₂ (vgl. Roblin am angegebenen Ort). Die Designänderungen eines Projektionsobjektivs bei Austausch von Quarzlinsen gegen BaF₂- oder SrF₂-Linsen in Bildnähe sind daher minimal. Das Projektionsobjektiv wird so durch den Einsatz von zwei kristallinen Materialien - CaF₂ für die Achromatisierung, BaF₂ oder SrF₂ gegen die Compaction optimiert.

[0021] Für ein 157 nm-Objektiv, rein refraktiv und aus einem Material, also CaF₂, wären Laserbandbreiten bis hinter zu 0,1 pm notwendig, abhängig von Apertur und Bildfeldgröße.

[0022] Es ist nicht zu erwarten, daß diese Werte einfach erreicht werden können beim Wechsel von 193 auf 157 nm. Alles wird nochmals anspruchsvoller, Materialdurchlässigkeit, Schichtverfügbarkeit, Gitter für die Laserkomponenten.

[0023] Erfindungsgemäß wurde mit BaF₂ ein Material gefunden, welches bei 157 nm transparent und isotrop ist, welches eine merklich höhere Dispersion bei 157 nm als CaF₂ besitzt und sich mit diesem zum Achromaten ergänzen läßt. BaF₂ absorbiert erst bei etwa 130 nm vollständig. Die Nähe der Absorptionskante zu 157 nm ist verantwortlich für den raschen Verlauf der Brechzahländerung (starke Dispersion) bei 157 nm. Entsprechendes gilt für andere Fluoride wie SrF₂.

[0024] Bei 193 nm ist die Achromatisierung durch die Kombination von CaF₂ und Quarzglas etabliert. BaF₂ hat eine nur unwesentlich höhere Dispersion als CaF₂ und liegt in der Dispersion sozusagen nutzlos zwischen der Dispersion von CaF₂ und Quarzglas.

[0025] Für 157 nm ändert sich die Situation, da Quarzglas erhöhte Absorption zeigt. Nach bisheriger allgemeiner Meinung gab es nun für CaF₂ keinen geeigneten Partner zur Achromatisierung.

[0026] Dies ist nicht der Fall: Der Dispersionsabstand zwischen CaF₂ und BaF₂ bei 157 nm fällt zwar kleiner aus als zwischen CaF₂ und Quarzglas bei 193 nm, aber es läßt sich unter moderatem Einsatz von BaF₂ immer noch sehr gut teilachromatisieren, auf ähnlichem Niveau wie bei 193 nm, z.B. 50% Farblängsfehlerreduktion.

[0027] Bei 193 nm wird allgemein nur eine Teilachromatisierung durchgeführt, um das eingesetzte CaF₂ Volumen aus Gründen der Kosten, der Verfügbarkeit und der Materialeigenschaften klein zu halten. Bei 157 nm wird man den Partner BaF₂ im Volumen kleinhalten wollen, da er ein höheres spezifisches Gewicht hat und sich die BaF₂-Linsen dadurch unter der Schwerkraft stärker durchbiegen.

[0028] Bei 193 nm möchte man möglichst alles aus Quarzglas machen, bei 157 nm möglichst alles aus CaF₂. Da die Zahl der positiven Linsen im refraktiven Lithographie-Objektiv deutlich größer ist als die der negativen, wäre es vorteilhaft bei 193 nm, wenn Quarzglas eine kleine Dispersion hätte. Es ist aber umgekehrt, CaF₂ hat die kleinere Dispersion und kann nicht bzw. soll nicht in allen positiven Linsen eingesetzt werden. Es werden also positive Linsen aus Quarzglas gemacht, was den Grad der Achromatisierung drückt.

[0029] Bei 157 nm ist es ebenfalls wünschenswert, daß das bevorzugte Material, hier CaF₂, eine kleinere Dispersion als der Partner hat.

[0030] Im Gegensatz zu 193 nm ist dies bei 157 nm mit BaF_2 der Fall. Fast alle Linsen, sicher alle positiven Linsen, können aus dem Kron, nämlich CaF_2 , sein. Einige wenige Negativlinsen werden aus BaF_2 gemacht, alternativ aus SrF_2 , denn dafür gilt qualitativ das gleiche wie für BaF_2 .

[0031] Natürlich gelten die obigen Aussagen auch für Linsen in einem katadioptrischen Objektiv, insbesondere auch für dabei vewendete refraktive Teilobjektive. Das erfindungsgemäße Objektiv kann also auch katadioptrisch sein. Wichtig ist, daß Linsen, und nicht nur optische Hilfselemente wie Umlenkprismen oder Planplatten aus Kristall bestehen.

[0032] Möchte man Lithographie mit einer kürzeren Wellenlänge als 157 nm und gleichzeitig mit sehr hoher numerischer Apertur betreiben, begegnet man einer Fülle schon bekannter Probleme in verschärfter Form. Zunächst muß man sich im Klaren sein, daß nur bei Excimer-Laserwellenlängen eine geeignete Bandbreite und Ausgangsleistung der Lichtquelle zu erwarten ist. Die Spektren der Edelgase emittieren zwar auch etwa ab 60 nm, nur sind diese sehr breitbandig und damit nur reinen Spiegelsystemen zugänglich. Reine Spiegelsysteme mit wirklich ausgedehntem Feld zwischen 10 und 26 mm haben bis jetzt keine Apertur größer NA = 0,6.

[0033] Excimer-Laser können auf folgenden Wellenlängen unterhalb von 157 nm betrieben werden:

NeF 109 nm Ar2 126 nm ArKr 134 nm Kr2 147 nm

10

[0034] Bei der Materialfrage ist ein bekannter Kandidat mit sehr guter Transmission für 134 und 147 nm CaF₂. Für 134 und 147 nm sind katadioptrische Objektive mit ausschließlich CaF2 als Linsenmaterial denkbar und stellen somit nichts Neues dar. Möchte man refraktive Objektive mit mehr Apertur bekommen, wie 0,80/0,85/0,90, so erschließt sich die Wellenlänge 147 nm noch durch das oben für 157 nm angegebene Materialsystem: Positive Linsen vorwiegend aus CaF₂, einige negative Linsen aus BaF₂. Da die Absorptionskante von BaF₂ etwa bei 134,5 nm liegt, ist man noch etwa 13 nm bei 147 nm entfernt. Dies bedeutet eine erhöhte Absorption, ermöglicht aber eine entspanntere Farblängsfehlerkorrektion, da BaF₂ bei 147 nm nun eine stärkere Dispersion hat als bei 157 nm, und zwar mit höherer Zunahme als CaF₂, da die Absorptionskante von CaF₂ bei 125 nm liegt.

[0035] Mit anderen Worten: bei gleich guter Bandbreite der Laser von 157 nm und 147 nm liefert bei einem rein refraktiven Objektiv ein Materialpaar CaF₂ und BaF₂ bei 147 nm das bessere Ergebnis hinsichtlich Farbkorrektur. Die Absorptionsverluste sind allerdings höher.

[0036] Auch bei 134 nm wurde bisher kein Materialpaar zur Achromatisierung rein refraktiver Systeme angegeben. Erfindungsgemäß wurde dies in dem Materialpaar CaF₂ - SrF₂ gefunden. Der Abstand zur Absorptionskante von SrF₂ bei 130 nm muß aber als sehr gering eingestuft werden. Die erhöhte Absorption läßt den Kristall nur für sehr dünne und kleine Negativlinsen sinnvoll erscheinen. Deshalb wird ein derartiges System nur für kleinere Bildfelder, etwa ein Halbfeldsystem (Stitching) realistisch sein.

[0037] Bei 126 nm scheidet auch CaF₂ vollständig aus, da der Abstand zur Absorptionskante nur noch 1 nm beträgt.

[0038] Es bleiben als bekannte Werkstoffe MgF₂ und LiF. MgF₂ ist auch bei 126 nm stark doppelbrechend und damit ungeeignet. LiF ist bei 126 nm zwar durchlässig, gilt aber für kleinere Durchmesser als ungeeignet, da die Strahlungsbelastung steigt und das Material sich dadurch unzulässig verändert (Transmission und Brechzahl). Selbst ein katadioptrisches System kommt im Bereich der höchsten Apertur (vor der Bildebene) nicht ohne Material im Durchtritt aus. Somit würde man für 126 nm kein hochgeöffnetes Lithographieobjektiv mit großem Feld mehr bauen können.

[0039] Erfindungsgemäß kann nun ein weiteres Material speziell für die hochbelasteten Meinen Durchmesser angegeben werden. Die Konfiguration bei 126 nm besteht aus einem katadioptrischen Lithographieobjektiv, welches hauptsächlich aus LiF besteht. In den mit hoher Strahlungsimtensität belasteten Linsen besteht es jedoch aus der isotropen amorphen Form von BeF₂. Die kristalline Form ist ähnlich dem kristallinen Quarz doppelbrechend. Die glasig erstarrte Form, ähnlich dem Quarzglas, ist bei entsprechender Herstellung isotrop. Da BeF₂ bei 126 nm deutlich laserresistenter ist als LiF, ist es das geeignete Material in wenigen Linsen entweder in einer Strahltaille oder mehreren Strahltaillen und/oder am bildseitigen Ende des Objektivs. Die geringe Zahl von BeF₂-Linsen ist letztlich anzustreben, da BeF₂ als starkes Atemgift und schwächeres Kontaktgift eingestuft werden muß. Für den Infrarotbereich gibt es schon lange Fertigungslinien, die den Umgang mit giftigen optischen Komponenten beherrschen. Trotzdem ist es vorteilhaft, die Zahl der BeF₂-Linsen auf das Allernotwendigste zu beschränken. Es handelt sich also um ein refraktives oder katadioptrisches Lithographieobjektiv aus mindestens einem kristallenem und einem glasigen Fluorid.

[0040] BeF $_2$ muß wasserfrei hergestellt und bearbeitet werden, da es zu H $_2$ 0-Aufnahme neigt und das H $_2$ 0 sofort die Wellenlänge 126 nm sperrt.

[0041] Besonders H₂0-arme BeF₂-Herstellung macht auch die HeF-Laserwellenlänge bei 109 nm zuganglich. Beide Komponenten in hochreiner Form, LiF und BeF₂, ermöglichen ein katadioptrisches Objektiv bei 109 nm.

[0042] Optische Materialien großer Dispersion werden herkömmlich als Flint(glas), solche geringer Dispersion als Kron(glas) bezeichnet.

[0043] Für die verschiedenen DUV bis VUV-Wellenlängen werden gemäß Obengesagtem die im folgenden kompakt wiedergegebenen Materialkombinationen vorgeschlagen:

- 193 nm:	- CaF ₂ Kron	KF Flint
	- CaF ₂ Kron	KF + SiO ₂ -Glas Flint
	- LiF +, CaF ₂ Kron	KF Flint
	- LiF +, CaF ₂ Kron	KF + SiO ₂ -Glas Flint
- 157 + 147 nm:	CaF ₂ und/oder LiF Kron	NaF, BaF ₂ , und/oder SrF ₂ Flint
- 134 nm:	- CaF ₂ Kron	SrF ₂ Flint
,	- CaF ₂ Kron	NaF Flint
	- LiF Kron	. SrF ₂ Flint
	- LiF Kron	NaF Flint
	- LiF Kron	NaF + SrF ₂ Flint
	dabei SrF ₂ für kleine Durchmesse	er, da strahlungsbeständiger als NaF

[0044] Die oben genannten Systeme können mit Dünnschichtsystemen aus MgF₂ und LaF₃ entspiegelt werden. Für 193 nm eignen sich zudem auch SiO₂ und Al₂O₃ als Antireflexschichten.

[0045] Diese Möglichkeit der Entspiegelung ist eine wichtige Voraussetzung für die Realisierbarkeit von vielgiledrigen refraktiven Objektiven, da sonst pro Linsenfläche ca. 10 % Reflexionsverlust auftritt.

[0046] Da für 126 nm und 109 nm keine Antireflex-Schichten bekannt sind, ist dies ein weiterer Grund, warum hier katadioptrische Systeme mit wenigen (z. B. 3-5) Linsen vorzuziehen sind, entsprechend Anspruch 12.

[0047] Beim Achromatisieren mit LiF und NaF bietet sich eine Möglichkeit, Grenzflächen Kristall-Gas einzusparen, damit auch Antireflexschichten bzw. Reflexionsverluste, gemäß den Ansprüchen 13 und 14.

[0048] Die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmeausdehnung beider Stoffe sind sehr ähnlich:

Wärmeleitfähig- keit	Ausdehnung
LiF 4,01 W/m/K	37,0 * 10 ⁻⁶ /C
NaF 3,75 W/m/K	36,0 * 10 ⁻⁶ /C

[0049] Damit kann ein "Kittglied" durch Ansprengen geschaffen werden, das je eine + und -Linse oder zwei + und eine -Linse enthält. Da die Brechzahlen beider Kristalle sehr niedrig sind und die Entspiegelung daher schwierig, ist diese Kittgliedbildung besonders hilfreich.

[0050] Neben einzelnen solcher Kittglieder könnte das Objektiv ansonsten aus CaF2-Linsen bestehen.

[0051] Auch angesprengte Glieder aus CaF₂ und BaF₂ sind möglich:

5

10

15

20

30

35

45

50

Wärmeleitfähigkeit	Ausdehnung
CaF ₂ 19,71 W/m/K	18,8 * 10 ⁻⁶ /C
BaF ₂ 11,72 W/m/K	18,1 * 10 ⁻⁶ /C

[0052] Erst die ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeiten der Kristalle gegenüber Gläsern läßt derartige Ansprengungen sicher erscheinen, insbesondere bei unterschiedlicher Absorption (und damit Erwärmung).

[0053] Als weitere Kristalle sind vor allem Mischkristalle des Fluor geeignet, darunter solche mit Alkali oder Erdalkali und anderen Elementen, wie Zinn, Zink oder Aluminium. Hohe Dispersion und gute Lichtbeständigkeit bei hoher Transmission im VUV sind dabei die Auswahlkriterien, bei Meidung von Doppelbrechung.

[0054] Natürlich gelten die obigen Aussagen auch für Linsen in einem katadioptrischen Objektiv, insbesondere auch für dabei verwendete refraktive Teilobjektive. Das erfindungsgemäße Objektiv kann also auch katadioptrisch sein. Wichtig ist, daß Linsen, und nicht nur optische Hilfselemente wie Umlenkprismen oder Planplatten aus Kristall bestehen.

[0055] Näher erläutert wird die Erfindung anhand der Zeichnung, deren

Figur 1 einen Linsenschnitt eines 157 nm Mikrolithographie-Projektionsobjektivs mit BaF2-Linsen zeigt;

Figur 2 einen Linsenschnitt eines 157 nm Mikrolithographie-Projektionsobjektivs mit NaF-Linsen und Asphären zeigt;

Figur 3 ein qualitatives Bild einer Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie zeigt;

Figur 4 schematisch ein Projektionsobjektiv mit Kittglied zeigt; und

Figur 5 schematisch ein katadioptrisches Projektionsobjektiv zeigt.

[0056] Zu dem in Figur 1 im Linsenschnitt gezeigten Ausführungsbeispiel gibt Tapelle 1 die Daten an.

[0057] Es handelt sich um ein Mikrolithographie-Projektionsobjektiv für den F_2 -Excimer-Laser bei 157 nm. Durch den Einsatz von CaF_2 und BaF_2 (für die Linsen 17, 18, 21, 24, 26, 28, 30) gelang es, bei einer Bandbreite von 0,5 pm, einem Stitching-gerechten Bildfeld von 8,0 x 13,0 mm², einem Reduktionsfaktor von 4,0 : 1, einem Abstand Objekt Ob zu Bild Im von 1000 mm und bei beidseitiger Telezentrie eine numerische Apertur von 0,8 zu verwirklichen. Eine weitere Erhöhung der numerischen Apertur ist durchaus möglich. Der Farblängsfehler wird um Faktor 3 gegenüber einem reinen CaF_2 Objektiv reduziert. Er beträgt noch CHL (500 pm) = 0,095 mm. Dieser Faktor kann durch zusätzliche CaF_2 - BaF_2 Linsenpaare noch gesteigert werden. Der gesamte RMS-Fehler der Wellenfront im Bild IM liegt für alle Bildhöhen bei RMS < 13 m λ , wobei ja die deutlich reduzierte Wellenlänge als Bezugsmaß λ diemt.

[0058] Die Brechzahlen bei der Hauptwellenlänge $\lambda_0 = 157,63$ nm des F₂-Excimer-Lasers und in 500 pm Abstand bei $\lambda_1 = 158,13$ nm sind

10

15

40

[0059] Daraus ergibt sich eine Abbe-Zahl (invers zur Dispersion):

υCaF ₂ = 1219	$vBaF_2 = 874$	$vSrF_2 = 392$
บLiF = 674	υNaF = 242	υKF = 184.

[0060] Damit hat bei 157 nm BaF₂ eine um 40% höhere Dispersion als CaF₂. Im Vergleich hat bei 193 nm Quarzglas eine um 54% Dispersion als CaF₂.

[0061] Das Projektionsobjektiv nach Figur 1 und Tabelle 1 hat insgesamt 39 Linsen und eine planparallele Abschlußplatte P. Sieben Negativlinsen 17, 18, 21, 24, 26, 28 und 30 sind zur Achromatisierung aus BaF₂ gemacht. Die Konstruktion steht in direkter Verwandtschaft zu dem in der obengenannten nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung DE 19855157.6 (deren Inhalt auch Teil dieser Anmeldung sein soll) beschriebenen Design.

[0062] Im Bereich der Systembiende AS ist eine - nicht stark eingeschnürte - dritte Taille T3 bei der Linse 26 ausgebildet, folgend auf die schon klassische Folge von Bauch B1 an Linse 5, Taille T1 an Linse 10, Bauch B2 an Linse 15, Taille T2 an Linse 18 und Bauch B3 an Linse 22, sowie gefolgt von Bauch B4. Besonders hoch entwickelt ist die Linsengruppe von Linse 20 bis 39 mit dem Doppelbauch B3, B4.

[0063] Mehrere sphärisch überkorrigierende Lufträume mit größerer Dicke in der Mine als am Rand sind im Bereich der Blende AS zwischen den Linsen 23/24, 26/27 und 29/30, 30/31 als wesentliches Korrektionsmittel vorgesehen. Dieser Aufbau begrenzt auch bei größter numerischer Apertur die Linsendurchmesser. Die in Tabelle 1 angegebenen Linsenradien - entsprechend den jeweils größten Strahlhöhen - zeigen, daß der Linsendurchmesser maximal 190 mm am

Bauch B4 beträgt. Auch sind die Linsendurchmesser ziemlich gleichmäßig verteilt, von Linse 13 im Bereich des zweiten Bauchs B2 bis Linse 34 nahe dem Bild IM liegen alle Linsendurchmesser zwischen 140 mm und 190 mm.

[0064] Die negativen BaF₂-Linsen 21, 24, 26, 28, 30 sind in klassischen + - Paaren mit positiven CaF₂-Linsen 22, 23, 25, 27, 29 abwechselnd im Bereich des Doppelbauchs B3, B4 vorwiegend vor der Blende AS angeordnet und werden durch zwei negative BaF₂-Linsen 17, 18 im Bereich der zweiten Taille T2 ergänzt. Damit ergibt sich ein sehr wirksamer Einsatz des zweiten Kristallmaterials zur Achromatisierung.

[0065] Der den Ansprüchen 9 oder 10 gemäße Einsatz zweier Kristall-Linsenwerkstoffe ergibt sich ausgehend von den beispielsweise aus den Patentanmeldungen DB 19855108.8 und DB 19855157.6 des Anmelders vom gleichen Anmeldetag und aus anderen Quellen bekannten Objektivdesigns dadurch, daß bei einem DUV-Objektiv (300-180 nm) mit überwiegend Quarzglas-Linsen und vorwiegend blendennahen, der Achromatisierung dienenden CaF2-Linsen die dem Bild IM nächsten Linsen - entsprechend in Figur 1 Linsen 39, 38 usw. - aus Quarzglas oder CaF2, jetzt durch BaF2-oder SrF2-Linsen ersetzt werden. Die nur wenig anderen optischen Eigenschaften des BaF2 und des SrF2 gegenüber Quarzglas erfordern nur routinemäßige Designänderungen mit einem Optik-Design-Programm. Natürlich kann auch die Planplatte P sinnvoll aus BaF2 gemacht werden. Wird sie jedoch - als Verschleiß- und Schutzelement - ohnedies öfters gewechselt, kann sie auch aus Quarzglas bleiben (im oben genannten Wellenlängenbereich)

[0066] Das Ausführungsbeispiel der Figur 2 zeigt ein 157 nm-Vollfeld-Scanner-Projektionsobjektiv auf der Basis von CaF₂-Linsen, das durch den Einsatz von insgesamt fünf Negativlinsen 218, 219, 220, 221; 232, 233, 234, 235; 236, 237; 249, 250; 257, 258 aus NaF in den beiden Taillen, im Blendenraum und im konvergierenden Strahlengang vor der Bildebene Im achromatisiert ist.

[0067] Insgesamt drei asphärische Linsenflächen 211, 221, 257, davon zwei auf NaF, tragen zur guten Korrektur bei kompaktem, materialsparendem Bau des Objektivs bei.

[0068] Abbildungsmaßstab 1:4, Bildfelddurchmesser 27,2 mm für ein 8 x 26 mm Scanner-Vollfeld und bildseitige numerische Apertur von NA = 0,77 sind wesentliche Kenndaten des Objektivs, dessen RMS-Bildfehler über alle Bildhöhen unter 16 m λ liegt, bei einer Laser-Bandbreite von $\Delta\lambda$ = \pm 0,2 pm. Die chromatische Längsaberration für den Vergleichswert $\Delta\lambda$ = 500 pm beträgt CHL (500 pm) = 0,153 mm. Die einzelnen Geometriedaten sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Der größte genutzte Linsendurchmesser beträgt 46 mm an der Linse 247, 248.

[0069] Die Gestaltung und Nutzung der Asphären erfolgt hierbei nach den Grundsätzen der Patentanmeldung DE 199 22 209.6 vom 14. Mai 1999 des gleichen Erfinders und Anmelders, die hiermit als Teil der Offenbarung auch dieser Anmeldung gelten soll.

[0070] Die in Figur 3 schematisch dargestellte Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie umfaßt als Lichtquelle 301 einen Excimer-Laser, eine Einrichtung 302 zur Bandbreitenreduktion - die auch im Laser integriert sein kann -, ein Beleuchtungssystem 303 mit Homogenisierungs- und Feldblendeneinrichtung u.a., einen Maskenhalter 304 mit Positionier- und Bewegungseinrichtung 314. Ein erfindungsgemäßes Projektionsobjektiv 305 umfaßt Linsen 315, 325 aus verschiedenen Kristallen bzw. Fluoriden. In der Bildebene wird das Objekt auf einem Objekthalter 306 mit Positionier- und Bewegungseinrichtung 316 bereitgestellt. In der Ausführung als Scanner werden Masken- und Objekthalter synchron in um den Abbildungsmaßstab unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegt. Natürlich gehören die hier nicht dargestellten Einrichtungen einer Projektionsbelichtungsanlage wie Steuer- und Regelsysteme, Autofokus, Wafer- und Maskenwechselsysteme, Klimatisierung auch dazu.

[0071] Figur 4 zeigt ein Objektiv 400 mit einem "Kittglied" 401, d.h. eine ohne Luftspalt gefügte Linsengruppe, die in diesem tiefen UV-Bereich durch Ansprengen gehalten wird, da kein strahlungsbeständiger Kitt/Kleber verfügbar ist. Wie oben gesagt, sind solche Glieder mit positiven LiF und negativen NaF Linsen sinnvoll bzw. mit BaF₂ und CaF₂. Weitere Linsen 402 im Objektiv 400 sind dann z.B. aus CaF₂ oder einem anderen der oben beschriebenen Materialien gefertigt.

[0072] Figur 5 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes katadioptrisches Objektiv, wie es für die Lithographie mit 126 nm oder 109 nm vorgeschlagen wird.

[0073] Das Objekt Ob wird mittels 4 Spiegeln M1 bis M4 und 4 Linsen L1 bis L4 auf die Bildebene Im abgebildet. Eine Linse L1 ist mit dem Spiegel M1 zu einem Mangin-Spiegel vereinigt. Dies erleichtert die Fertigung und reduziert Reflexionsverluste und-störungen. Die Linsen L1, L3, L4, in denen das Strahlungsbündel großen Querschnitt und damit geringe Intensität aufweist, sind aus LiF gefertigt. Die bildnahe Linse L2, die zur Steigerung der numerischen Apertur gebraucht wird, ist aber konzentrierter Strahlung ausgesetzt. Hierfür wird amorphes BeF₂ eingesetzt, wegen seiner höheren Strahlungsbeständigkeit.

[0074] Das katadioptrische Objektiv soll wegen der Absorption und der relativ schwierigen Herstellung der Linsenwerkstoffe nur wenige Linsen, d.h. 1 bis 10, enthalten. Derartige Mikrolithographie-Projektionsobjektive sind z.B. für 193 nm bekannt, vgl. US 4,701,035 Fig. 12 und US 5,815,310 Fig. 3 mit NA = 0,6 und Quarzglas als Linsenmaterial. Von solchen Systemen ausgehend können konkrete Ausführungen erfindungsgemäßer Objektive abgeleitet werden, unter Vorgabe der optischen Eigenschaften der neu vorgegebenen Materialien.

[0075] Auch für die anderen Objektivkonstruktionen der Erfindung ist grundsätzlich die Detailkonstruktion mittels Design-Programmen aus vorhandenen Designs abzuleiten. Dafür sind Brechzahl und Dispersion der Materialien bei

den jeweiligen Betriebswellenlängen einzusetzen.

[0076] Aus "Handbook of Optics", McGraw-Hill 1995, Ch. 33 Properties of Crystals and Glasses, p. 33.64, ref. [125] sind beispielsweise die Dispersionskurven von

LiF ab 100 nm NaF ab 150 nm, mit Extrapolation ab 130 nm KF ab 150 nm, mit Extrapolation ab 130 nm

bekannt.

5

45

50

55

[0077] Zu den Absorptionskanten von BaF₂, CaF₂, MgF₂, SrF₂ und LiF₂ finden sich Informationen in GB 1 276 700 betreffend ein Bandpaßfilter bei 130 nm.

[0078] Optische Konstanten der angesprochenen Antireflexschichten finden sich beispielsweise in M. Zukic et al. Applied Optics 29 No. 28, Oct. 1980, p 4284-4292.

[0079] Die angegebenen Literaturstellen sind natürlich nur Beispiele. Außerdem können die genauen optischen Eigenschaften auch durch Vermessung von Proben mit einem UV-Spektrometer gewonnen werden.

[0080] In der Tabelle 3a sind die Abbezahlen υ einiger Fluoride und zum Vergleich von Quarzglas für die Wellenlängen des ArF- und des F_2 -Excimerlasers angegeben.

[0081] Daraus abgeleitet sind die Quotienten der Abbezahlen in Tabelle 3b für verschiedene Kron/Flint kombinationen bei 157 nm angegeben. Großer Quotient bedeutet starke Farbfehlerkorrektur mit wenig Flint.

[0082] Demnach wäre die Kombination Kron LiF, Flint KF ideal. Die schwierigen Eigenschaften von KF sprechen aber dagegen (Absorption, Wasserempfindlichkeit).

[0083] Jedoch kann mit dem Kron CaF₂ nur die Kombination mit NaF gegenüber den Kombinationen mit LiF als Kron konkurrieren.

[0084] Sobald die Herstellung von Linsen aus LiF der von CaF₂-Linsen vergleichbar gut möglich ist, sind also Objektivkonstruktionen mit LiF als Kron vorzuziehen, in Kombination etwa mit BaF₂ oder NaF.

[0085] Der erfindungsgemäße Einsatz von Kristall-Linsen bringt auch bei katadioptrischen Systemen im Wellenlängenbereich 100 bis 200 nm die gleichen Vorteile.

[0086] Eine Projektionsbelichtungsanlage mit erfindungsgemäßem Objektiv entspricht zum Beispiel den aus den genannten Patentanmeldungen und anderen Quellen bekannten Aufbauten, jetzt allerdings mit dem erfindungsgemäßen Objektiv.

[0087] Für 157 nm Systeme ist ein F₂-Excimer-Laser mit moderatem Aufwand zur Bandbreitenbegrenzung, ein angepaßtes Beleuchtungssystem z.B. nach der Patentanmeldung DE 19855106, jedenfalls mit Fluorid und/oder Spiegel-Optik, aber auch z.B. mit erfindungsgemäßem Objektiv, vorzusehen. Dazu kommen Masken- und Wafer-Positionier- und Handlingssysteme usw. zu dem erfindungsgemäßen Projektionsobjektiv.

[0088] Diese asphärischen Flächen werden durch die Gleichung:

$$P(h) = \frac{\delta^{+}h^{2}}{1+\sqrt{1-(-EX)^{+}\delta^{2}}h^{2}} + C_{1}h^{4} + ... + C_{n}h^{2n+2} \qquad \delta = 1/R$$

beschrieben, wobei P die Pfeilhöhe als Funktion des Radius h (Höhe zur optischen Achse 7) mit den in den Tabellen angegebenen asphärischen Konstanten C_1 bis C_n ist. R ist der in den Tabellen angegebene Scheitelradius.

Tabelle 1

Eleme	nt Krümmungsradius	Dicke	Material	Linsenradius	_
ОЬ	∞	8,646		34,52	
1	-89,212	4,219	CaF₂		
	-16234,578	5,440		38,01	
2	-264,742	5,333	CaF ₂		
	252,387	7,720		43,32	
3	-660,451	1 7,777	CaF ₂		
	-140,998	,752		50,10	
4	1064,631	16,556	CaF ₂		
	-158,471	,750		57,46	
5	334,549	20,500	CaF ₂		
	-185,783	,750		61,97	
6	123,299	18,438	CaF ₂	60,05	
	6416,942	,250			
7	80,830	6,933	CaF ₂	52,10	
	59,684	29,393			
8	-270,673	7,923	CaF ₂	45,95	
	-138,947	1,854			
. 9	-4994,395	6,686	CaF ₂	42,27	
	100,936	20,795			
10	-77,364	5,536	CaF ₂	38,79	
	138,364	18,752			
11	-102,745	16,748	CaF,		
	-267,729	7,811		52,63	
12	-130,631	24,060	CaF ₂		
	-118,058	, 755		63,21	
13	-17113,629	30,658	CaF ₂		
	-185,673	,550		77,37	

EP 1 006 373 A2

	14	-763,483 ⁻	14,068	CaF_2	
		-257,169	,450		81,41
5	15	538,062	17,501	CaF ₂	
		-524,097	,450		83,64
	16	225,158	28,126	CaF ₂	82,00
10		-455,940	,450		
	17	288,200	5,280	BaF ₂	73,64
		116,070	43,999		
15	18	-136,780	5,899	BaF ₂	
		596,541	30,232	•	70,04
	19	-126,579	12,715	CaF ₂	
20		-160,434	,450		77,54
	20	1476,691	23,253	CaF ₂	
		-252,721	,450		86,85
25	21	-2817,234	11,778	BaF ₂	
		231,190	1,794		. 90,96
	22	231,573	53,989	CaF ₂	
30		-192,300	,453		93,26
	23	362,633	20,787	CaF ₂	88,11
		-787,951	9,876		
35	24	-299,764	10,937	BaF_{2}	86,45
	-	190,174	,750		-
	25	183,395	50,343	CaF ₂	83,31
40		-174,748	2,226		
	. 26	-164,440	10,352	BaF ₂	82,14
		168,479	5,874		81,42
45	27	206,740	50,425	CaF ₂	
		-153,785	1,751		82,83
	28	-154,941	8,763	BaF ₂	
50		-1457,609	,700		84,91
	29	254,394	43,058	CaF ₂	87,38

EP 1 006 373 A2

	AS	Blende	,000		87,38
5		-217,033	9,211		
	30	-162,604	12,000	BaF ₂	
		-511,982	32,352		89,88
10	31	-179,731	19,652	CaF ₂	
		-150,853	1,959		83,87
	32	357,035	16,035	CaF ₂	92,29
15		2402,661	,935		
	33	141,252	27,158	CaF ₂	86,94
20		445,801	,751	•	
	34	121,230	20,012	CaF ₂	75,94
		251,005	,750		
25	35	89,189	18,534	CaF ₂	62,04
•		183,720	7,397		
	36	490,596	13,526	CaF ₂	58,00
30		255,332	,750		48,00
	37	77,348	8,959	CaF ₂	39,69
<i>35</i>		53,255	7,818		
	38	115,034	2,770	CaF ₂	30,44
		27,832	1,250		
40	. 39	27,548	14,863	CaF ₂	22,66
		193,984	2,347		
	P	∞	1,211	CaF ₂	18,16
45	IM	æ			17,43

	Element	Krūmungsradius	Dicke	Material	
	OF		17.3892 .		
•	2	-134.1462-	9.9551	CAF2	
5	3	-195.6788	.7000	CATE,	
	4	-256.1348	10.3165	CAF 2	Tabelle 2
	5	-215.7111	.7000	11.1	Tabelle 2
	6	-1185.4145	12.7743	CAF2:	
	7	-266.9759	.7000	<i></i>	
10	8	768.1676	17.0432	CAF2	
70	9	-326.8752	.7000		
	10	201.9820	20.6243	CAF2!	
	11	-1127.2372 A	.7000		
	12 13	194.8406 103.5380	10.7431	CAF2:	
	14	-429.7364	29.220\$ 7.0000	C123	
15	15	157.9775	22.6930	CAF2	
,,,	15	-211.6271	7.1822	CAF2	
	17	-176.9514	.7253	W 2	
	18	-205.5616	7.0000	NAF	୍ରେ କୁ
	19	207.9612	36.0232		<u> </u>
	20	-119.6353	7.2489	NAF	723 368 029
20	21	-413.0417 A	10.3725)54. [34:
20	22	-218.9613	19.5719	CAF2	27C 181
	23	·153.12:1	.7433		ما ما ما
	24	-1678.0689	38.5656	CAF2	6, 6, 0
	25 25	-171.3517· 390.5431:	14.2594 55.0613	F4 F3:	ζ_3 .22009617E-11 ζ_4 .2991689E-16 ζ_5 .27054723E-19 ζ_9 .22507210E-11 ζ_4 .13590312E-16 ζ_5 .1813458E-19 ζ_7 .09097234E-13 ζ_7 .221893 ζ_7 E-16 ζ_5 .16469029E-20
	27	-340.4367:	1.0036	CAF2	9E.
25	28	170.6572	41.3431	CAF2	668 031
	29	2149.7419	.7000	CALE	391 359
	30	179.2959	13.8028	CAF2	2 1 2
	31	122.0160	35.7868		سن بن بن
	32	-451.7398	7.0000	NAF :	3 - 5
	33	181.5824	30.6167	· .	E E E
30	34	·161.3435	7.0000	NAF :	21.04
	35 36	163.5622 -111.4273	41.2995 7.1263	3145 .	0960
	37	736.5475	19.4254	NAF ;	222
	38	-304.5919	18.3054	CAF2	
	39	-195.3438	.7785	54. L	G. 9. C.
	40	-1945.5147	28.2366	CAF2	97 97 97 98
<i>35</i>	41	-231.5183	.8597	:	3 2 8 8 8
	42	622.3005	42.0816	CAF2	814 460 885 131
	43	-517,5539;	.0001		.14048141E-07 .47644602E-27 .13628853E-07 .23291310E-27
	ĀB	• •	2.8420		N (2,14048141E-07 ((2,47644602E-27 (2,1362863E-07 (2,23291310E-27 (2,46722013E-08
		AES 7060	32 6647		~ COB 60 50
	45 46	056.7969 •609.0558	32.9647 .8543	CAF2	₩
40	47	328.0241	39.3550	CAFZ:	AT 0.000
	48	-810.7543	33.1869	CAC E.	198 GE 22 GE
	49	-246.7339	9.3143	NAF	RISCIE KONSTANI 15637086E+03 37664501E-23 95744229E+00 .24243733E-23
	50	-513.0495	15.0989		SCII 376 376 957
	51	·342.1676·	18.3964	CAF2	
.=	52	-240,4190	.9015		৴৶ৣঢ়৶ৣ৺
45	53	142.3229:	36.3765	CAF2	ASA A A
	54	358.3715	2.3965		
	55	131.5538-	23.5624	CAF2i	स् ्ञ ८
	56 67	257.3044	15.9366		
	S7 58	-1240.0410 A 269.2267	10.0142	NAF	
50	59	113.1907	.7289 23.1921	CAF2	
50	60	47.2586	2.3140	بالمر	
	61	46.5346	30.1367	CAF2	
	62	354.0845	15.8942		
	IM				

Tabelle 3a

Abbezahlen				
Wellenlänge	193,63 nm	157,63 nm		
LiF	1344,27	674,56		
CaF ₂	1024,36	436,94		
SrF ₂	954,39	391,89		
BaF ₂	807,43	344,42		
SiO ₂	714,96	274,61		
NaF	705,92	242,51		
KF	648,04	184,19		

Definition

5

10

15

20

25

30

35

40

55

 $\frac{v}{193} = \frac{n\ 193,304 - 1}{n193,304 - n\ 193,804}$

 $v_{157} = \frac{n\ 157,63 - 1}{n157,63 - 158,13}$

Tabelle 3b

Dispers	Dispersionsvergleich 157 nm			
Flint	Kron LiF	Kron CaF ₂		
CaF ₂	1,549	-		
SrF ₂	1,721	1,115		
BaF ₂	1,959	1,269		
NaF	2,782	1,802		
KF	3,662	2,372		

Patentansprüche

- 1. Objektiv mit Linsen aus mindestens zwei verschiedenen Kristallen.
 - 2. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Linsen aus mindestens zwei verschiedenen Fluoriden, insbesondere aus CaF₂, BaF₂, SrF₂, LiF, NaF, KF bestehen.
- Objektiv nach Anspruch 1 oder 2 mit zusätzlichen Linsen aus glasartigem Material, insbesondere Quarzglas oder amorphem BeF₂.
 - 4. Projektionsobjektiv der Mikrolithographie, korrigiert für die Beleuchtung mit einem F₂-Excimer-Laser bei 157 nm, dadurch gekennzeichnet, daß es rein refraktiv ist und Linsen aus BaF₂, SrF₂, NaF, LiF oder KF enthält.
 - Projektionsobjektiv nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als weiteres Kristall-Linsenmaterial CaF₂ eingesetzt ist.

- Projektionsobjektiv nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß einzelne Negativlinsen aus BaF₂ oder SrF₂ oder NaF gefertigt sind.
- 7. Projektionsobjektiv nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß alle Positivlinsen und einzelne Negativlinsen aus CaF₂ gefertigt sind.
- 8. Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die bildseitige numerische Apertur über 0,5, vorzugsweise über 0,6, beträgt.
- Refraktives Projektionsobjektiv der Mikrolithographie, korrigiert für die Beleuchtung mit Wellenlängen unter 360
 nm, enthaltend Linsen aus Quarzglas, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der beiden der Bildebene
 des Objektivs nächsten Linsen aus Kristall, vorzugsweise CaF₂, SrF₂ oder BaF₂, ausgeführt ist.
- 10. Objektiv nach Anspruch 3 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß es ein mikrolithographisches Projektionsobjektiv, korrigiert für die Laser-Beleuchtung mit einer Wellenlänge unter 360 nm, ist und die meisten Linsen aus Quarzglas, mehrere positive Linsen vorzugsweise in Blendennähe, zur Achromatisierung aus CaF₂ und eine oder mehrere objektseitige Linsen zum Verhindern des Compaction-Einflusses aus BaF₂ oder einem anderen Fluorid, inspesondere SrF₂, gefertigt sind.
- 20 11. Projektionsobjektiv der Mikrolithographie mit einer Arbeitswellenlänge von 100 180 nm mit Linsen aus mindestens zwei der Kristall-Materialien CaF₂, BaF₂, LiF, NaF, SrF, KF oder des amorphen BeF₂.
 - Projektionsobjektiv der Mikrolithographie, ausgeführt als katadioptrisches Objektiv mit einer Arbeitswellenlänge von 100 - 130 nm enthaltend Linsen aus LiF und/oder amorphem BeF₂.
 - Achromat-Linsengruppe bestehend aus aneinander angesprengten Linsen aus verschiedenen Fluoriden, insbesondere NaF und LiF oder CaF₂ und BaF₂.
 - 14. Projektionsobjektiv mit mindestens einer Achromat-Linsengruppe nach Anspruch 13.
 - 15. Objektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Linse eine asphärische Fläche aufweist.
- Objektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß Linsen eine Dünnschicht Entspiegelung aus MgF₂ und/oder LaF₃ tragen.
 - 17. Projektionsbelichtungsanlage mit 157 nm Lichtquelle und refraktivem Projektionsobjektiv.
 - 18. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie

25

40

- mit einer Lichtquelle, enthaltend einen Excimer-Laser mit 100 160 nm, vorzugsweise 100 150 nm Wellenlänge.
- mit einem Beleuchtungssystem, enthaltend refraktive optische Elemente aus einem oder mehreren Fluoriden, insbesondere Alkali- oder Erdalkalifluoriden,
- einem Retikel-Positionier- und Bewegungssystem
- mit einem Projektionsobjektiv mit Linsen aus mindestens zwei der Kristall-Materialien CaF₂, BaF₂, LiF, NaF,
 SrF, KF oder des amorphen BeF₂.
- mit einem Objekt-Positionier- und Bewegungssystem
- Projektionsbelichtungsanlage, insbesondere nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 15 ausgeführt ist.
 - 20. Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß sie für das Stitching-Verfahren ausgelegt ist.
 - 21. Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß ein Excimer-Laser mit 109, 126, 134, 146 oder 157 nm Wellenlänge als Lichtquelle eingesetzt ist.

- 22. Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile, bei dem ein mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenes Substrat mittels einer Maske und einer Projektionsbelichtungsanlage nach mindestens einem der Ansprüche 17 bis 21 durch ultraviolettes Laserlicht belichtet wird und einer Abbildung eines auf der Maske enthaltenen Musters strukturiert wird.
- 23. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in mindestens einer Zerstreuungslinse ein Material eingesetzt ist, dessen Brechungsindex niedriger ist als der durchschnittliche Brechungsindex der in den Sammellinsen verwendeten Materialien.

